

wikiAzmoon  
wikiazmoon.ir

376

F



376F

نام

نام خانوادگی

محل اقامت

صحیح جمعه

۹۱/۱/۲۵

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

**آزمون ورودی  
دوره‌های دکتری (نیمه متاخر) داخل  
در سال ۱۳۹۱**

**رشته‌ی**

**مهندسی فناوری نانو - نانوالکترونیک (کد ۲۳۶۴)**

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ریاضی و فیزیک) ریاضی عمومی ۱ و ۲، ریاضی فیزیک ۱ و ۲، فیزیک پایه ۱ و ۲، مبانی نانوتکنولوژی، ادوات نیمه هادی پیشرفته)	۴۵	۱	۴۵

**فروردین سال ۱۳۹۱**

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

حق چاپ و تکثیر سوالات پس از برگزاری آزمون برای تمام اشخاص حقوقی و حقوقی نهادها ممنوع است و با منتقدین برای هرگز رفتار نمی شود.

اگر  $z = e^{x^{\frac{1}{2}} - y} (\Delta - 2x + y)$  نقطه یک نقطه است. -۱

(۱) (-۱, ۲)، زینی

(۲) (-۱, ۲)، ماقزیم

(۳) (۱, -۲)، زینی

(۴) (۱, -۲)، مینیم

منحنی  $r(t) = (t \cos t, t \sin t, \frac{\sqrt{t}}{3})$  در این صورت: -۲

$$t = s + s^{\frac{1}{2}}$$
 (۱)

$$t = -1 + \sqrt{1+s}$$
 (۲)

$$t = \sqrt{2} + \sqrt{2+s}$$
 (۳)

$$t = -1 + \sqrt{1+2s}$$
 (۴)

سری های  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^{2n}(n+2)}{(1+n)^{2n}}$  و  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n+1)^2}{3^n} e^{n+1}$  باشند. -۳

(۱) همگرا - همگرا

(۲) همگرا - واگرا

(۳) واگرا - همگرا

(۴) واگرا - واگرا

فرض کنید  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{n^{\frac{1}{2}}}{n^{\frac{1}{2}} + 1} + \frac{n^{\frac{1}{2}}}{n^{\frac{1}{2}} + 2} + \dots + \frac{n^{\frac{1}{2}}}{n^{\frac{1}{2}} + n}$  برابر است با: -۴

۳ (۱)

۲ (۲)

۱ (۳)

۰ (۴)

فرض کنید  $f(x) = \int_0^x \int_0^{t^{\frac{1}{2}} - 1} (h^{\frac{1}{2}} + \sin(h^{\frac{1}{2}} - 1)) dh dt$ . مقدار  $f''(\sqrt{2})$  کدام است؟ -۵

$\frac{\sqrt{2}}{2}$  (۱)

$2(\sqrt{2} - 1)$  (۲)

$2\sqrt{2} - 1$  (۳)

$2\sqrt{2}$  (۴)

-۶ فرض کنید  $F = (x^r + \sin(y^r z^r), y^r + \sqrt{x}e^x + z, z^r + y \cos(x^r))$  و  $S$  سطح بسته‌ای باشد که کره

$$\iint_S F \cdot dS \text{ را محدود می‌سازد.} \quad \text{کدام است؟}$$

۱)  $10\pi\sqrt{5}$

۲)  $20\pi\sqrt{5}$

۳)  $100\pi$

۴)  $125\pi$

-۷ مقدار انتگرال  $\int_C (\sin(e^{x^r}) - y^r)dx + (\cos(e^{y^r}) + x^r)dy$  که در آن  $C$  مرز نیم دایره  $x^r + y^r \leq 4$  و  $y \geq 0$  است که خلاف جهت عقربه‌های ساعت جهت‌دار شده است، کدام است؟

۱)  $3\pi$

۲)  $6\pi$

۳)  $12\pi$

۴)  $24\pi$

-۸ اگر  $\vec{A}$  و  $\vec{B}$  دو بردار ثابت باشند، حاصل عبارت  $(\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{r})) \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$  کدام است؟

۱)  $\vec{A} \times \vec{B}$

۲)  $3(\vec{A} \times \vec{B})$

۳)  $3(\vec{A} \cdot \vec{B})$

۴)  $(\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{r}$

-۹ کدام عبارت در مورد ویژه مقادیر یک ماتریس یکانی (یونیتاری) درست است؟

۱) ویژه مقادیر آن یک و منهای یک هستند.

۲) ویژه مقادیر آن همواره حقیقی هستند.

۳) قدر مطلق ویژه مقادیر آن برابر یک است.

۴) ویژه مقادیر آن همواره موهومی خالص هستند.

-۱۰ ماتریسی که ماتریس  $A = \begin{pmatrix} 3 & i \\ -i & 3 \end{pmatrix}$  را قطری می‌کند، کدام است؟

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ i & -1 \end{pmatrix} (1)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} (2)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} (3)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & 1 \\ -i & 1 \end{pmatrix} (4)$$

- ۱۱ در معادله دیفرانسیل مرتبه دو  $x^2y''(x) + xy'(x) + (x-2)y = 0$  نقطه تکین ..... و نقطه  $x=2$  نقطه تکین ..... است. منظم (regular) – نامنظم (irregular)
- (۱) منظم – منظم
  - (۲) منظم – نامنظم
  - (۳) نامنظم – نامنظم
  - (۴) نامنظم – منظم

-۱۲ معادله دیفرانسیل  $x^2y''(x) - 4xy'(x) + 8y(x) = 0$  با تغییر متغیر  $x = e^t$  به چه شکلی در می‌آید؟

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \omega y = 0 \quad (1)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + \varepsilon t y = 0 \quad (2)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} - \delta \frac{dy}{dt} + \varepsilon y = 0 \quad (3)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} - \varepsilon t \frac{dy}{dt} + \varepsilon t^2 y = 0 \quad (4)$$

-۱۳ حاصل انتگرال  $\int_0^\infty \frac{x^2 dx}{(x^2+1)(x^2+4)}$  کدام است؟ (راهنمایی: از روش حساب مانده‌ها استفاده کنید.)

$$-\pi \quad (1)$$

$$-\frac{\pi}{4} \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{8} \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{4} \quad (4)$$

-۱۴ در فضای سه بعدی تانسور مرتبه چهار  $C_{ijkl} = C_{ijlk}$  صدق می کند دارای چند مؤلفه

مستقل است؟

۱۵ (۱)

۲۱ (۲)

۲۷ (۳)

۳۶ (۴)

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } |x| < a \\ 0 & \text{if } |x| > a \end{cases} \quad \text{کدام است؟} \quad -۱۵$$

$$-\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-ika}}{k} \quad (۱)$$

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \left( \frac{\sin(ka)}{k} \right) \quad (۲)$$

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \left( \frac{\cos(ka)}{k} \right) \quad (۳)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{ika}}{k} \quad (۴)$$

-۱۶ جسم  $m$  متوسط نیروی وارد  $\bar{F}$  و ادار به حرکت روی سقف یک اطاق شده است. اگر  $g = \frac{\pi}{4}$ ,  $F = 100 \text{ N}$ ,  $m = 4 \text{ kg}$

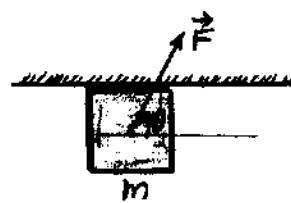
ضریب اصطکاک جنبشی جسم با سقف  $4/5$  باشد، شتاب جسم تقریباً چند  $\frac{m}{s^2}$  است؟

۶/۵ (۱)

۱۴/۵ (۲)

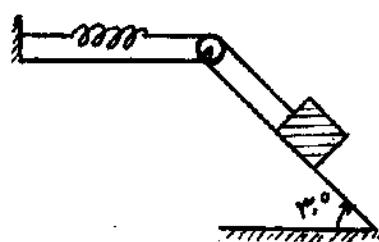
۲۰/۵ (۳)

۲۸/۵ (۴)



-۱۷ جعبه ۲ کیلوگرمی مطابق شکل روی سطح شیبدار بدون اصطکاکی با زاویه شیب  $30^\circ$  قرار دارد. جعبه توسط نخ سبکی که

از روی قرقره سبکی می گذرد به فنری سبک با ثابت فنر  $\frac{N}{m} = 200$  متصل است. جعبه از حالت سکون در حالتی که فنر کشیده شده نیست رها می شود. جعبه قبل از ایستادن لحظه‌ای چند ساعتی متوجه روی سطح شیبدار پایین می رود؟ اصطکاکی قرقره ناچیز است.



۵ (۱)

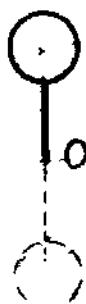
۸/۵ (۲)

۱۰ (۳)

۱۷ (۴)

-۱۸ قطعه‌ای شامل یک حلقه نازک به شعاع  $30\text{ cm}$  و میله متصل به آن به طول  $60\text{ cm}$  می‌تواند به طور آزاد حول انتهای میله ( نقطه O ) آزادانه دوران کند. جرم حلقه و میله متصل به آن یکسان است. در ابتدا میله و حلقه به طور قائم هستند. اگر بر اثر یک ضربه ناچیز این قطعه حول نقطه O به دوران درآید سرعت زاویه‌ای قطعه در حالتی که حلقه به پایین ترین نقطه

$$\left( g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \text{ است؟} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

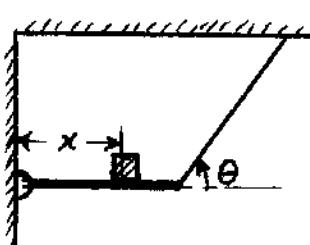
(۱)  $6/5$ (۲)  $4/85$ (۳)  $3/4$ (۴)  $0/85$ 

-۱۹ در شکل زیر میله افقی یکنواختی به جرم  $m$  و طول  $L$  از طرف چپ توسط لولایی به دیوار قائم و از سمت راست توسط کابلی که با افق زاویه  $\theta$  می‌سازد به سقف متصل است. وزنهای به جرم  $M$  روی میله و به فاصله  $x$  از دیوار قائم قرار دارد. اگر رابطه

$$T = 500 + 600 \frac{x}{L} \quad (\text{T برو حسب نیوتن})$$

کشش در کابل و  $x$  به صورت قابع  $T = 500 + 600 \frac{x}{L}$  و مجموع وزن میله و وزنه  $1000$  نیوتن

$$\left( g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \text{ باشد، جرم وزنه چند کیلوگرم است؟}$$

(۱)  $37/5$ (۲)  $30$ (۳)  $54/5$ (۴)  $60$ 

-۲۰ ذره‌ای به جرم  $m$  و سرعت  $v$  نسبت به یک ناظر معین منفجر شده و به دو ذره تقسیم می‌شود که یک ذره جرمش چهار برابر دیگری است. انفجار در فضای خالی انجام گرفته است. ذره سبک‌تر نسبت به ناظر ساکن است. انرژی جنبشی ذره دوم چند برابر انرژی جنبشی ذره اولیه قبل از انفجار است؟

 $\frac{3}{4}$  (۱) $\frac{4}{5}$  (۲) $\frac{4}{3}$  (۳) $\frac{5}{4}$  (۴)

-۲۱

یک استوانه عایق بسیار بلند به شعاع  $6\text{ cm}$  و ثابت دی الکتریک  $4\text{ D}$  دارای بار الکتریکی با چگالی حجمی غیر یکنواخت

$$\rho = A r^3 \text{ است. اندازه میدان الکتریکی در نقطه‌ای به فاصله}$$

$$\frac{\mu C}{m^5} \text{ از محور استوانه تقریباً چند} \frac{V}{m} \text{ است؟}$$

$$r = 4\text{ cm}$$

(۱) ۰/۰۵۸

(۲) ۰/۱۴

(۳) ۰/۲۳

(۴) ۰/۵۶

-۲۲

بار مثبت  $Q$  در نقطه ثابت  $P$  قرار دارد. ذره دیگری با جرم  $m$  و بار منفی  $q$  - با تنیدی ثابت روی دایره‌ای به شعاع  $r_1$  و به

مرکز  $P$  حرکت می‌کند. کار لازم برای آن که شعاع دایره حرکت این ذره به  $r_2 = 3r_1$  افزایش یابد کدام است؟

$$\frac{1}{2} \left( \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r_1} \right) \quad (1)$$

$$\frac{2}{2} \left( \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r_1} \right) \quad (2)$$

$$\frac{4}{2} \left( \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r_1} \right) \quad (3)$$

$$\frac{2}{2} \left( \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r_1} \right) \quad (4)$$

-۲۳

در شکل زیر  $C_1 = 10\text{ }\mu\text{F}$ ،  $C_2 = 8\text{ }\mu\text{F}$ ،  $C_3 = 10\text{ }\mu\text{F}$  و  $C_4 = 7\text{ }\mu\text{F}$  است. ابتدا خازن‌های ۱ و ۲ به باطری  $V$

۲۴ متصل‌اند. ابتدا باری روی خازن ۴ وجود ندارد پس از بسته شدن کلید  $S$  و شارژ کامل خازن ۴ مقدار باری که در این مدت

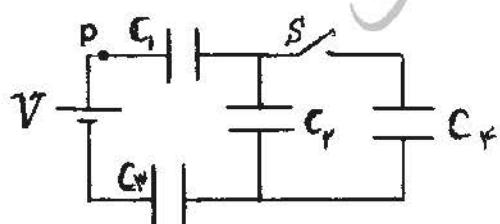
از نقطه  $P$  عبور می‌کند چند میکروکولن است؟

(۱) ۱۰

(۲) ۲۰

(۳) ۷۰

(۴) ۹۰



-۲۴ یک مقاومت ۴ مگا اهمی و یک خازن ۲ میکرو فارادی به صورت سری با یک باطری آیدهال با نیروی محرکه ۱۲ ولتی بسته شده‌اند. پس از ۲ ثانیه از بسته شدن مدار با چه نرخی بار روی خازن بر حسب  $\frac{\mu C}{s}$  افزایش می‌یابد؟

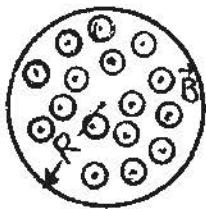
$$2e^{-\frac{t}{4}} \quad (1)$$

$$2e^{-\frac{t}{2}} \quad (2)$$

$$2(1-e^{-\frac{t}{4}}) \quad (3)$$

$$2(1-e^{-\frac{t}{8}}) \quad (4)$$

-۲۵ در شکل زیر ناحیه‌ای به شعاع  $R = 4 \text{ cm}$  نشان داده شده که در آن شار میدان الکتریکی یکنواختی عمود بر صفحه کاغذ و به سمت خارج از آن وجود دارد. شار الکتریکی کل گذرنده از این ناحیه برابر  $\Phi_E = 4t \text{ Vs}$  است که در آن  $\Phi_E$  بر حسب  $V \cdot m$  و  $t$  بر حسب ثانیه است. اندازه میدان مغناطیسی القایی در نقطه‌ای به فاصله  $2 \text{ cm}$  از مرکز دایره تقریباً چند تسل است؟



$$8.8 \times 10^{-19} \quad (1)$$

$$3.5 \times 10^{-18} \quad (2)$$

$$3.5 \times 10^{-16} \quad (3)$$

$$8.8 \times 10^{-17} \quad (4)$$

-۲۶ در نمودار پتانسیل یونیزاسیون خوش‌های اتم‌های فلزی بر حسب تعداد اتم‌های موجود در خوش، محل قله‌ها منطبق بر است.

(۱) اعداد جادویی ساختاری و الکترونی

(۲) اعداد جادویی الکترونی اتم هیدروژن

(۳) اعداد جادویی مدل زله‌ای

-۲۷ کدام عبارت در مورد فولرین نادرست است؟

(۱) بلور  $\text{C}_60$  خالص در دمای ۱۸ درجه کلوین ابررسانا می‌شود.

(۲) مولکول فولرین ۱۲ وجه بینج ضلعی و ۲۰ وجه شش ضلعی دارد.

(۳) بلور  $\text{C}_60$  عایق است اما با آلایش با یک اتم قلیایی از نظر الکتریکی رسانا می‌شود.

(۴) مولکول‌های فولرین در حالت جامد تشکیل یک شبکه‌ی بلوری FCC می‌دهند که فاصله هر مولکول از نزدیکتری همسایه آن یک نانومتر است.

-۲۸ شبکه بلوری گرافن .....

(۱) یک شبکه براوا است.

(۲) یک شبکه مربعی با پایه دو گربنی است.

(۳) یک شبکه براوای مثلثی با پایه سه گربنی است.

-۲۹

کدام عارت در مورد روش سل - ژل نادرست است؟

- (۱) با افزایش دمای تکلیس اندازه کریستالیت‌ها افزایش می‌یابد.
  - (۲) نانو ذرات سرامیکی اکسیدی را از این روش نمی‌توان تولید کرد.
  - (۳) pH محلول اثر قابل توجهی بر مشخصات نانوذرات تولید شده از این روش دارد.
  - (۴) عامل کی لیت کننده و غلظت آن نقش مهمی در اندازه و موروفولوژی نانوذرات تولیدی دارد.
- از میان آنالیزهای نامبرده در زیر کدام یک براساس تابش پرتو الکترونی به هدف کار می‌کند:

-۳۰

**PL-۵ RHEED-۴ AES-۳ XPS-۲ LEED-۱**

- (۱) آنالیزهای ۱ و ۲ و ۴
- (۲) آنالیزهای ۱ و ۳ و ۵
- (۳) آنالیزهای ۲ و ۳ و ۴
- (۴) آنالیزهای ۳ و ۴ و ۵

کدام عبارت در مورد میکروسکوپ‌های نیروی اتمی (AFM) نادرست است؟

- (۱) با این دستگاه می‌توان سطح رسانا یا عایق را بررسی کرد.
- (۲) با این دستگاه می‌توان نقاط مختلف سطح و ناخالصی سطحی را تعیین کرد.
- (۳) با این دستگاه می‌توان مغناطش و قطبش در نقاط مختلف سطح را تعیین کرد.
- (۴) برای تصویر برداری حتماً باید نوک سوزن همواره با سطح مورد بررسی در تماس باشد.

-۳۱

کدام عبارت در مورد خاصیت مواد نانوساختار نادرست است؟

- (۱) نانومیله‌های SiC خواص مکانیکی کامپوزیت‌ها را شدیداً ارتقا می‌بخشند.
- (۲) در نقاط کوانتومی از طریق کنترل قطر ذرات، یک طول موج خاص نوری را می‌توان جذب یا نشر نمود.
- (۳) ساختارهای نانوکریستال دارای استحکام کمتری نسبت به ماده حجیم هستند و فعالیت اتم‌ها در مرز دانه‌ها بسیار کم است.
- (۴) نانو میله‌های NiTe<sub>2</sub> برای کاربردهای ترموالکتریک مناسبند و برای اندازه‌گیری اختلاف دمایی در مقیاس نانومتری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

-۳۲

نانو لوله کربنی با کدام کاپرالیته خاصیت فلزی دارد؟

- (۱) (۳ و ۱۴)
- (۲) (۵ و ۸)
- (۳) (۱ و ۹)
- (۴) (۵ و ۰)

-۳۳

کدام عبارت در مورد روش چگالش گاز خنثی نادرست است؟

- (۱) هر چه وزن اتمی و فشار گاز خنثی موجود در محفظه بالاتر باشد نانو ذرات ریزتری تولید می‌شود.
- (۲) از مهم‌ترین نانوذرات فلزی تولید شده به این روش، نقره، طلا، آهن و کبات است.
- (۳) در روش دینامیک که گاز خنثی در درون محفظه جریان دارد کنترل اندازه و توزیع نانو ذرات بهتر انجام می‌شود.
- (۴) هر چه دمای بوته بیشتر باشد ماده با نرخ بیشتری تبخیر و وارد محفظه می‌شود و موجب درشت‌تر شدن نانو ذرات نهایی می‌شود.

-۳۴

کدام عبارت در مورد روش پراکنش اتمی (Atomic sputtering) نادرست است؟

- (۱) در این روش امکان تولید نانو ذرات با ابعاد کوچکتر از ۱۰ نانومتر وجود دارد.
- (۲) از این روش برای تولید نانو ذرات اغلب فلزات و سرامیک‌های اکسیدی استفاده می‌شود.
- (۳) در این روش برخلاف دیگر روش‌های سنتز بخار مرحله چگالش اتم‌ها برای تشکیل نانو ذرات وجود ندارد.
- (۴) در این روش هدف ذوب نمی‌شود بلکه وقتی انرژی منتقل شده به اتم‌های هدف دارای مولفه سرعت عمود بر سطح و بزرگتر از انرژی سطحی باشند از سطح هدف جدا می‌شوند.

-۳۵

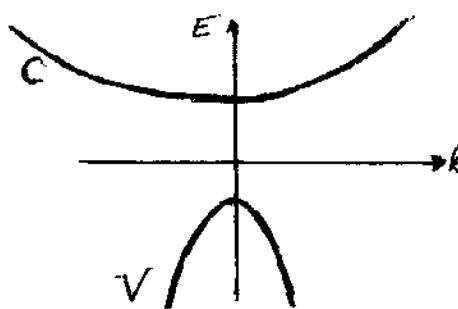
-۳۶ در طیف جذب اپتیکی نانو ذرات ساخته شده از عناصر نیمه رسانا با کاهش اندازه ذرات لبهی جذب ..... ، گاف انرژی و شدت جذب .....

- (۱) به انرژی های بالاتر منتقل می شود - افزایش می باید - زیاد می شود.
- (۲) به انرژی های بالاتر منتقل می شود - کاهش می باید - زیاد می شود.
- (۳) به انرژی های پایین منتقل می شود - افزایش می باید - زیاد می شود.
- (۴) به انرژی های پایین منتقل می شود - کاهش می باید - کم می شود.

-۳۷ نیمه دسانای GaAs دارای ساختار کریستالی ..... است و گاف انرژی ..... دارد و جرم مؤثر الکترون های دسانش آن ..... برابر جرم الکترون در فضای آزاد است.

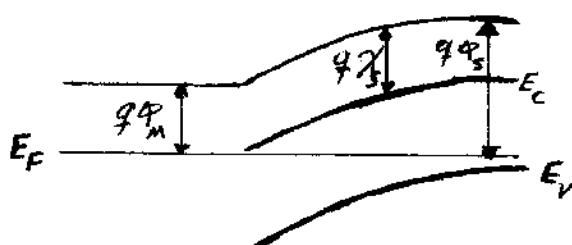
- (۱) نمک طعام - غیرمستقیم -  $567^{\circ}$
- (۲) نمک طعام - مستقیم -  $64^{\circ}$
- (۳) Zincblende - مستقیم -  $567^{\circ}$
- (۴) Zincblende - غیرمستقیم -  $64^{\circ}$

-۳۸ نمودار فوار انرژی یک نیمه دسانای مطابق شکل زیر است. اگر زمان پراکندگی الکترون ها و حفره ها برابر باشد کدام عبارت درست است؟  $\mu_p$  تحرک حفره ها،  $\mu_n$  تحرک الکترون ها،  $N_c$  چگالی الکترون های دسانا و  $N_v$  چگالی الکترون های ظرفیت است.



- (۱)  $N_v < N_c, \mu_p < \mu_n$
- (۲)  $N_v < N_c, \mu_p > \mu_n$
- (۳)  $N_v > N_c, \mu_p < \mu_n$
- (۴)  $N_v > N_c, \mu_p > \mu_n$

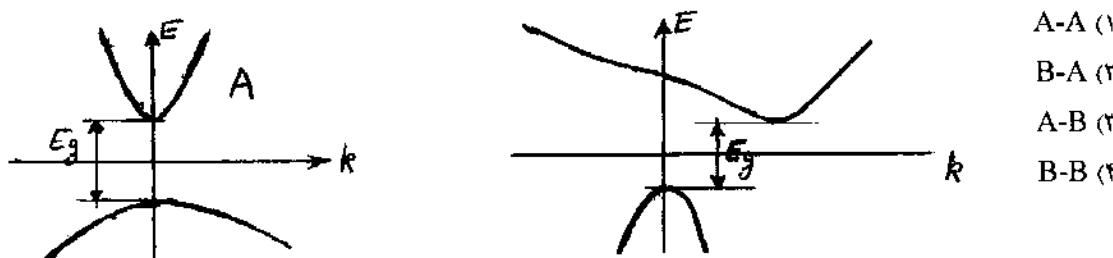
-۳۹ در یک مرز مشترک ایده اآل معین سلسیوم ( $\chi_s = 4,05\text{ V}$ ,  $E_g = 1,12\text{ eV}$ ) که چنان آلبیده شده که با مس ( $\phi_M = 4,4\text{ V}$ ) در حالی که میدان بایاس صفر باشد، افت ولتاژ میان فلز و نیمه رسانا چند ولت است؟



- (۱)  $0,67$
- (۲)  $1,02$
- (۳)  $1,37$
- (۴)  $1,87$

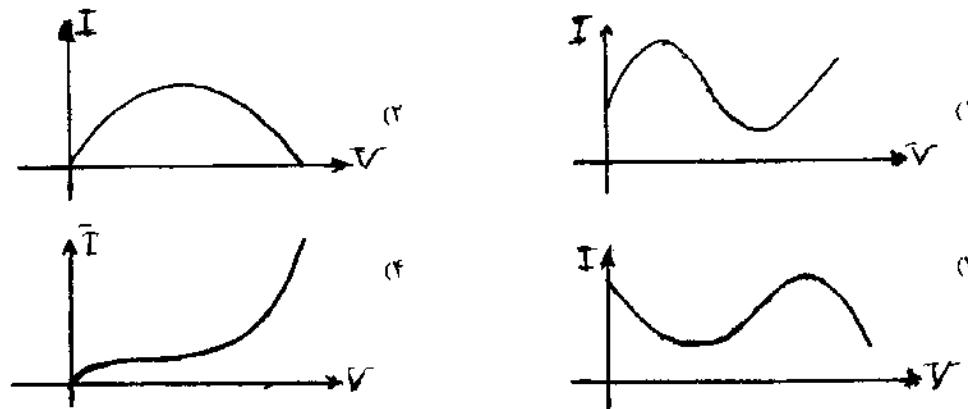
-۴۰-

نمودار نوار انرژی دو نیمه رسانای A و B مطابق شکل زیر است. تحرک (موبیلیته) نیمه رسانای ..... بیشتر و اکثر باز ترکیب در نیمه رسانای ..... منجر به گسیل فوتون می‌شود. زمان پراکندگی در دو نیمه رسانا یکسان است.



-۴۱-

نمودار مشخصه I جریان بر حسب V ولتاژ برای دیود تونلی GaAs کدام است؟



-۴۲-

کدام عبارت در مورد تریستورها (Thyristors) نادرست است؟

- (۱) دارای انتلاف حرارتی پایینی هستند.
- (۲) نمودار مشخصه V-I آن‌ها خطی است.
- (۳) دارای دو حالت پایدار on و off هستند.
- (۴) در فرایندهای تراپرد آن‌ها هم الکترون‌ها و هم حفره‌ها سهم دارند.

-۴۳-

نیمه رسانای  $P_x$ -GaAs برای  $x=0, 45^\circ$  دارای گاف ..... و برای  $x=90^\circ$  دارای گاف ..... است. و با افزایش x اندازه گاف ..... می‌یابد.

- (۱) مستقیم - مستقیم - افزایش
- (۲) غیرمستقیم - غیرمستقیم - افزایش
- (۳) غیرمستقیم - مستقیم - کاهش

کدام عبارت در مورد LED نادرست است؟

-۴۴-

- (۱) LED‌های فروسرخ در مخابرات فiber نوری با افت کمینه کاربرد دارند.
- (۲) نسبت به لیزرها، پهنای خط طیفی بیشتری در حدود ۵ تا ۱۵ نانومتر دارند.
- (۳) با افزایش غلظت حامل‌ها، طول عمر بازتر کیب تشعشعی افزایش یافته و موجب کاهش راندمان تشعشعی می‌شود.
- (۴) LED یک اتصال p-n است که تحت بیامس مستقیم حامل‌های اقلیت از دو طرف اتصال تزریق می‌شوند.

- ۴۵

لیزرهای نیمه هادی دارای گاف ..... هستند. زیرا در این نوع نیمه رساناهای گذار تشعشعی از مرتبه ..... ولذا احتمال گذار بیشتر است. و برای کاهش جریان آستانه بهتر است از ..... استفاده نمود.

ساختار چند لایه‌ی دوگانه (Single Heterostructure) - ساختار چند لایه‌ی تکی (Double Heterostructure)

- |  |  |
|--|--|
| ۱) غیرمستقیم دوم - ساختار چند لایه‌ی تکی | ۲) مستقیم - دوم ساختار چند لایه‌ی دوگانه   |
| ۳) غیرمستقیم - اول - ساختار چندگانه تکی  | ۴) مستقیم - اول - ساختار چند لایه‌ی دوگانه |